

КТ855А – КТ855В

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ
HIGH POWER MEDIUM FREQUENCY



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р-транзисторы КТ855А – КТ855В предназначены для работы в схемах мощных преобразователей, линейных стабилизаторов напряжения и других схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

Оформление – в пластмассовом корпусе.

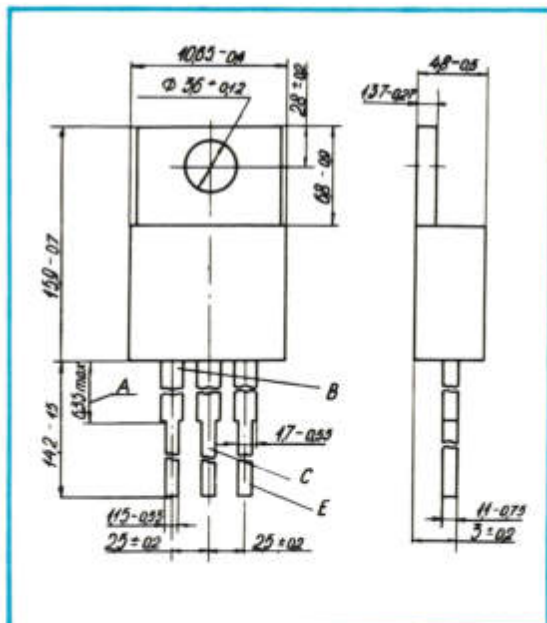
Диапазон допустимых рабочих температур от -40 до $+100^{\circ}\text{C}$.

GENERAL DESCRIPTION

The КТ855А – КТ855В transistors are Silicon planar-epitaxial p-n-p transistors designed for use in circuits of power converters or line-voltage regulators and other circuits, subassemblies and units in a wide range of applications.

The devices are encapsulated in plastic cases.

Allowable operating temperatures: -40 to $+100^{\circ}\text{C}$.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

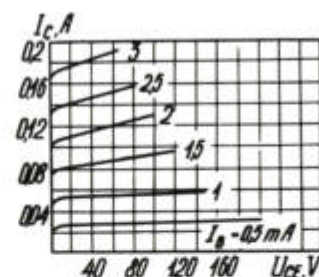
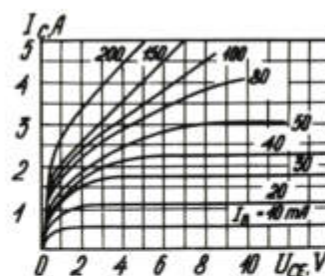
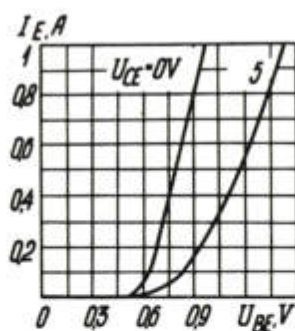
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{CB \text{ max}}$	
КТ855А	250 V
КТ855В, В	150 V
$U_{CE \text{ max}}$ ($R_{BE} < 10 \Omega$)	
КТ855А	250 V
КТ855В, В	150 V
$U_{EB \text{ max}}$	5 V
$I_B \text{ max}$	1 A
$I_C \text{ max}$	5 A
$I_{CM \text{ max}}$	8 A
$P_C \text{ max}$ ($t_{case} < +25^{\circ}\text{C}$)	
с теплоотводом heat sink	40 W
без теплоотвода free air	1,2 W
$t_j \text{ max}$	150°C

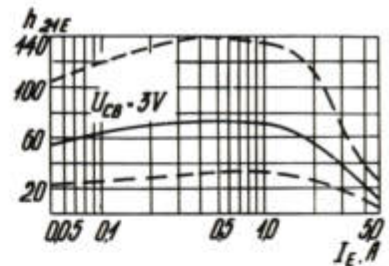
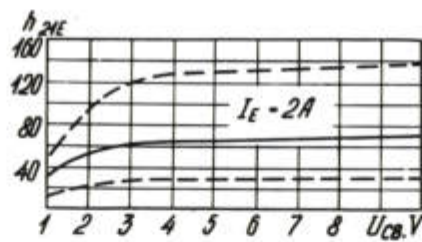
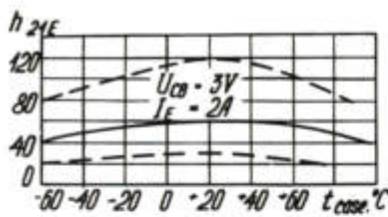
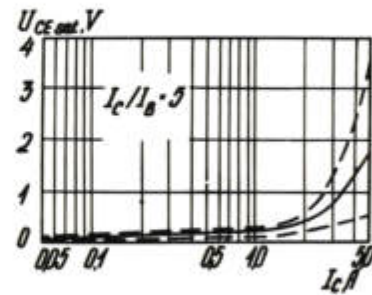
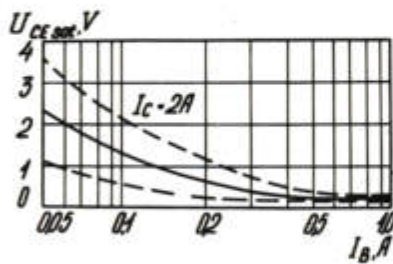
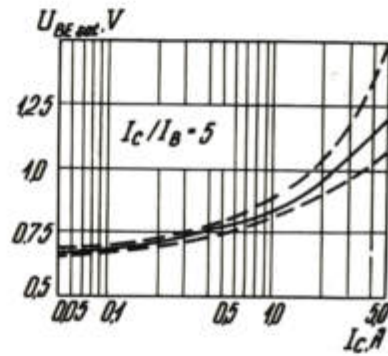
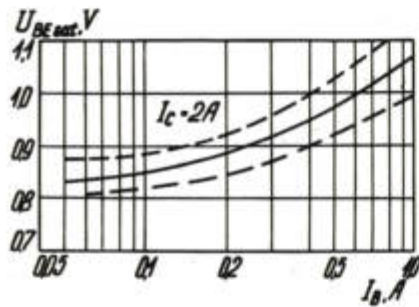
KT855A — KT855B

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions	
		$U_{CB}; U_{CE}^x; U_{EB}^{xx},$ V	$I_E; I_C^x;$ I_B^{xx}, A
I_{CBO}, mA			
KT855A	< 1	250	
KT855B	$< 0,1$	150	
KT855B	< 1	150	
I_{EBO}, mA			
KT855A, B	< 5	5^{xx}	
KT855B	$< 0,1$	5^{xx}	
$U_{(L)CEO}, V$			
KT855A	> 200		$0,05^x$
KT855B, B	> 150		$0,05^x$
h_{21E}			
KT855A, B	≥ 20	4^x	2^x
KT855B	> 15	4^x	2^x
$U_{CE sat}, V$	< 1		$2^x; 0,4^{xx}$
$U_{BE sat}, V$	$< 1,8$		$2^x; 0,4^{xx}$
f_T, MHz	> 5	5	0,1
C_c, pF	100 - 300	10	



KT855A — KT855B



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95** % РАЗБРОСА
SPREAD